



TRACCIA n. 1

Il candidato descriva gli elementi principali e le caratteristiche attese di un impianto "ion plating plasma assisted" idoneo alla deposizione di film sottili di SiO₂.

TRACCIA n. 2

Il candidato descriva le caratteristiche della deposizione con cannone elettronico di film sottili dielettrici, evidenziando i vantaggi di tale tecnica rispetto ad altre opzioni.

TRACCIA n. 3

Il candidato descriva il metodo di misura dello spessore di film sottili mediante accoppiatore a prisma e sorgenti laser.